

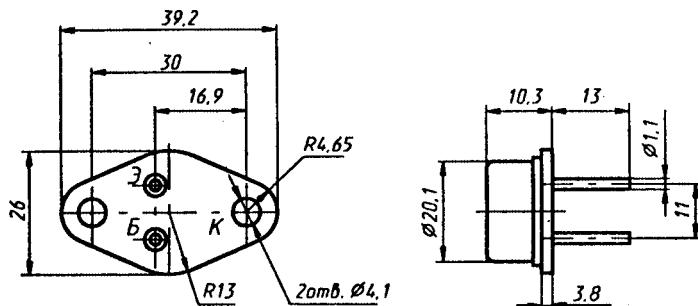
2T834A, 2T834B, 2T834B, KT834A, KT834B, KT834B

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *p-p-n* составные усиительные. Предназначены для применения в регуляторах тока и напряжения, в переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 22 г.

Изготовители — акционерное общество «Элиз», г. Фрязино, акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

2T834(A-B), KT834(A-B)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

при $U_{K3} = 5$ В, $I_K = 5$ А:

$T_K = +25^\circ\text{C}$ 150...500*...
3000*

$T_K = T_{K, \text{МАКС}}$, не менее 150

$T_K = T_{K, \text{МИН}}$, не менее 50

при $U_{K3} = 5$ В, $I_K = 10$ А, $T_K = +25^\circ\text{C}$ 60...250*...
1250*

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{K3} = 5$ В, $I_K = 5$ А, $f = 1$ МГц 4*...5*...7,8*

Границное напряжение при $I_K = 0,1$ А,

$L = 25$ мГн:

2T834A, KT834A 400...450*...
490* В

2T834B, KT834B 350...375*...
440* В

2T834B, KT834B 300...340*...
375* В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

$I_K = 15$ А, $I_B = 1,5$ А 1,2*...1,5*...2 В

Время спада при $U_{K3} = 250$ В, $U_{B3} = 5$ В,

$I_K = 10$ А, $I_B = 1$ А 0,25*...0,6*...
1,2* мкс

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $R_{B3} = 100$ Ом:

$T_K = +25^\circ\text{C}$, $U_{K3R} = U_{K3R, \text{МАКС}}$, не более 3 мА

типовое значение 0,2* мА

$T_K = T_{K, \text{МАКС}}$, $U_{K3R} = U_{K3R, \text{И. МАКС}}$, не более 3 мА

$T_K = T_{K, \text{МИН}}$, $U_{K3R} = U_{K3R, \text{И. МАКС}}$, не более 3 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{B3} = 5$ В,

не более 50 мА

типовое значение 25* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер¹

при $R_{B3} = 100 \text{ Ом}$, $T_k = -40 \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$:

2T834A, KT834A	500 В
2T834Б, KT834Б	450 В
2T834В, KT834В	400 В

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{B3} = 100 \text{ Ом}$, $t_{\phi} \geq 0,2 \text{ мкс}$:

2T834A, KT834A	400 В
2T834Б, KT834Б	350 В
2T834В, KT834В	300 В

¹ При $T_k = -40 \dots -60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и $T_k = +85 \dots +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $U_{K3,B,\max}$ снижаются линейно до 400 В для 2T834A, KT834A; 350 В для 2T834Б, KT834Б; 300 В для 2T834В, KT834В.

Постоянное напряжение база—эмиттер

8 В

Постоянный ток коллектора

15 А

Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 0,5 \text{ мс}$,

$Q \geq 100$

20 А

Постоянный ток базы

3,5 А

Импульсный ток базы при $t_i \leq 0,5 \text{ мс}$, $Q \geq 100$.

7 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора¹ при $T_k = T_{k,\min} \dots +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

100 Вт

Температура $p-n$ перехода

+150 °C

Температура окружающей среды:

2T834A, 2T834Б, 2T834В

$-60 \dots T_k \approx$
 $= +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

KT834A, KT834Б, KT834В

$-40 \dots T_k =$
 $= +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

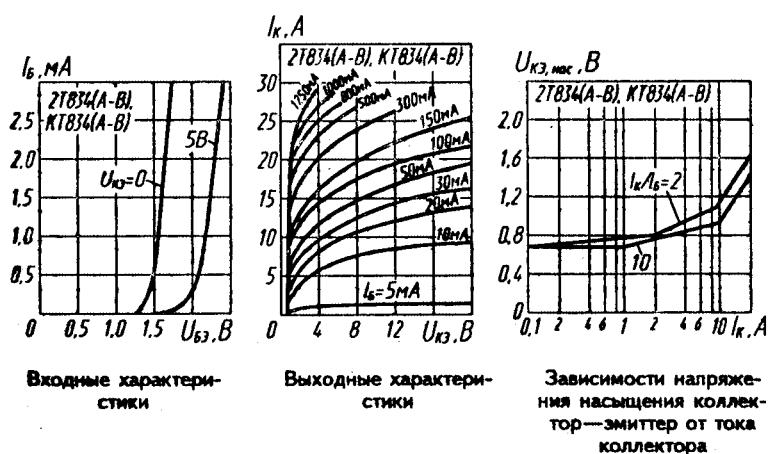
¹ При $T_k > +25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

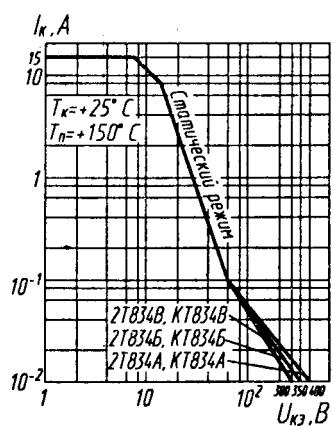
$$P_{K3,\max} = (T_p - T_k) / R_{T(p-k)}, \text{ Вт},$$

где $R_{T(p-k)}$ определяется из области максимальных режимов.

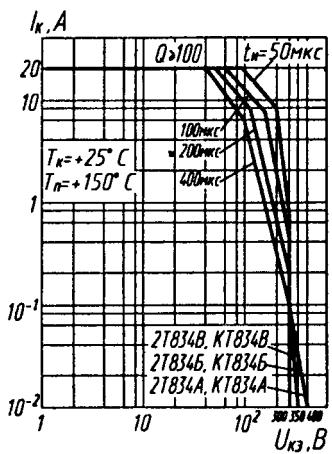
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер практически не зависит от сопротивления в цепи база—эмиттер (до 10 кОм). Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса паяльником с температурой не более +260 °C в течение не более 10 с.

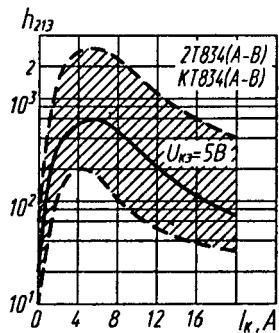




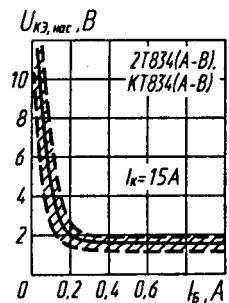
Области максимальных режимов



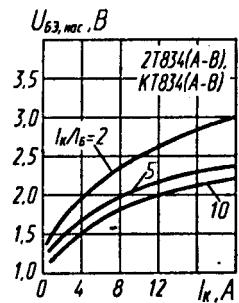
Области максимальных режимов



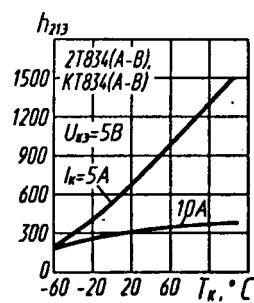
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



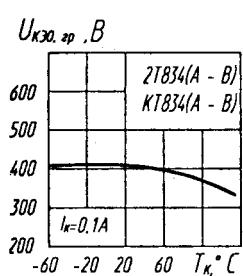
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока базы



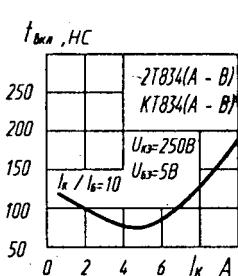
Зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



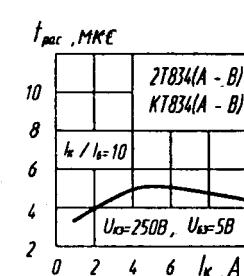
Зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



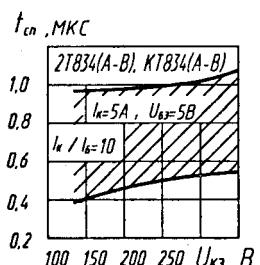
Зависимость граничного напряжения от температуры корпуса



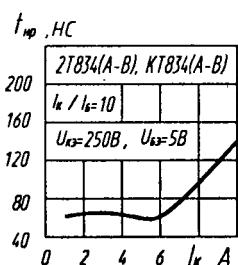
Зависимость времени включения от тока коллектора



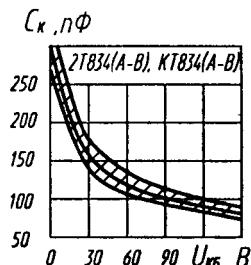
Зависимость времени рассасывания от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости времени спада от напряжения коллектор—эмиттер



Зависимость времени нарастания от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор—база